

News Release / Presseinformation

Infineon präsentiert neue Leistungstransistoren 650-V-CoolMOS™ C6/E6 für höchste Effizienz und einfache Kontrolle des Schaltverhaltens in Schaltnetzteilen

Neubiberg, 24. Juni 2010 – Die neuen leistungsfähigen 650-V-MOSFETs der CoolMOS C6/E6-Serie von Infineon Technologies kombinieren die Vorteile moderner SJ (Superjunction)-Bausteine mit einer einfachen Kontrolle des Schaltverhaltens sowie hoher Robustheit der leitenden Body-Diode. Diese Vorteile sind zum Beispiel ein geringer Durchlasswiderstand und reduzierte kapazitive Schaltverluste. Die neuen Hochvolt-MOSFET C6-Bausteine basieren auf der gleichen Plattform und sind für eine möglichst einfache Implementierung optimiert worden, während die E6-MOSFETs für höchste Effizienz ausgelegt sind.

CoolMOS C6/E6 ist die sechste Generation der Hochvolt-SJ-MOSFETs von Infineon. Die neuen 650-V-Leistungshalbleiter bieten eine schnelle und dennoch kontrollierte Schalt-Performance für Applikationen, die eine hohe Effizienz und Leistungsdichte erfordern. Die 650-V-CoolMOS C6/E6-Produkte lassen sich einfach integrieren und sind besonders geeignet für unterschiedliche energieeffiziente Schaltnetzteile wie Notebook-Adapter, Solar-Stromversorgungen oder andere Schaltnetzteil-Anwendungen, für die eine zusätzliche Ansteuerungsreserve für die Durchbruchsspannung entscheidend ist.

„Mit den neuen 650-V-C6/E6-Produkten ergänzt Infineon seine bisherige CoolMOS-C6/E6-Familie. Damit können wir die Vorteile der sechsten Generation der CoolMOS-Technologie auch für Anwendungen zur Verfügung stellen, die eine 650 V Sperrspannung erfordern“, sagte Jan-Willem Reynaerts, Product Line Manager HVMOS Power Discretes bei Infineon Technologies. „Damit bietet CoolMOS C6/E6 unseren Kunden einen hervorragenden Migrationspfad von der C3-Serie.“

Im Vergleich zur CoolMOS C3 650-V-Familie hat Infineon die in der Ausgangskapazität abgespeicherte Energie (E_{oss}) um bis zu 20 Prozent reduziert. Dank der weiter verbesserten Body-Diode sind die neuen Produkte robuster gegenüber harter Kommutierung und verringern die Sperrverzögerungs-Ladung um 25 Prozent. Das gute Schaltverhalten der C6/E6-Serie mit ihrem ausbalancierten Design und

optimierten Gate-Widerständen sorgt dafür, dass keine extremen Spannungs- und Strom-Gefälle auftreten.

Verfügbarkeit und Preise

Muster des IPA65R280C6 / IPA65R280E6 (280 mΩ in einem TO220-FullPAK-Gehäuse) und IPA65R380C6 / IPA65R380E6 (380 mΩ in einem TO220 FullPAK) sind verfügbar. Die Volumenfertigung dieser ersten Bauteile der neuen C6/E6-650-V-Serie beginnt im Juli 2010. Das Produktangebot wird kontinuierlich erweitert und die Familie bis Ende 2010 komplettiert.

Die Einzelstück-Preise für den IPA65R280C6 / IPA65R280E6 liegen bei 2,90 US-Dollar bei einem Bestellvolumen von 10.000 Stück.

Weitere Informationen findet man unter www.infineon.com/power oder www.infineon.com/c6e6

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 25.650 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2009 (Ende September) einen Umsatz von 3,03 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse/